

Схемы транзистора BUYP52



Обозначение контактов(международное):

С - коллектор, В - база, Е - эмиттер.

Материал р-п-перехода: *Si*

Структура транзистора: *NPN*

Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (P_c) транзистора: *50 W*

Предельное постоянное напряжение коллектор-база (U_{cb}): *120 V*

Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (U_{ce}) транзистора: *0 V*

Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (U_{eb}): *5 V*

Предельный постоянный ток коллектора транзистора ($I_c \max$): *5 A*

Предельная температура р-п перехода (T_j): *200 C*

Граничная частота коэффициента передачи тока (F_t) транзистора: *10 MHz*

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (H_{fe}), min: *10*

Корпус: *ТО3*